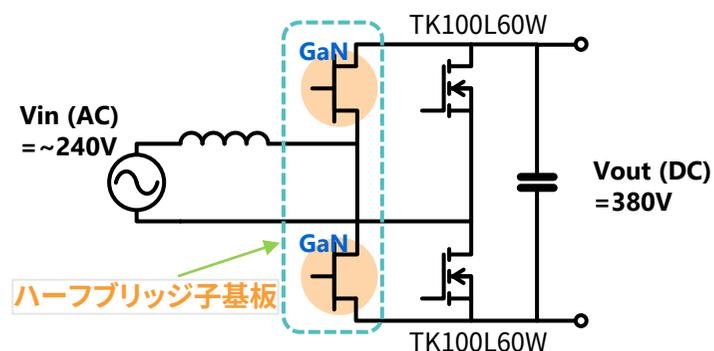


## GaNパワー搭載3.0kWトータムポールPFC\*<sup>1</sup>評価ボード

3.0kW Totem-Pole PFC Evaluation board with Toshiba GaN power device

### GaNパワーサンプル搭載3.0kWトータムポールPFC評価ボードはピーク効率99.1%を達成

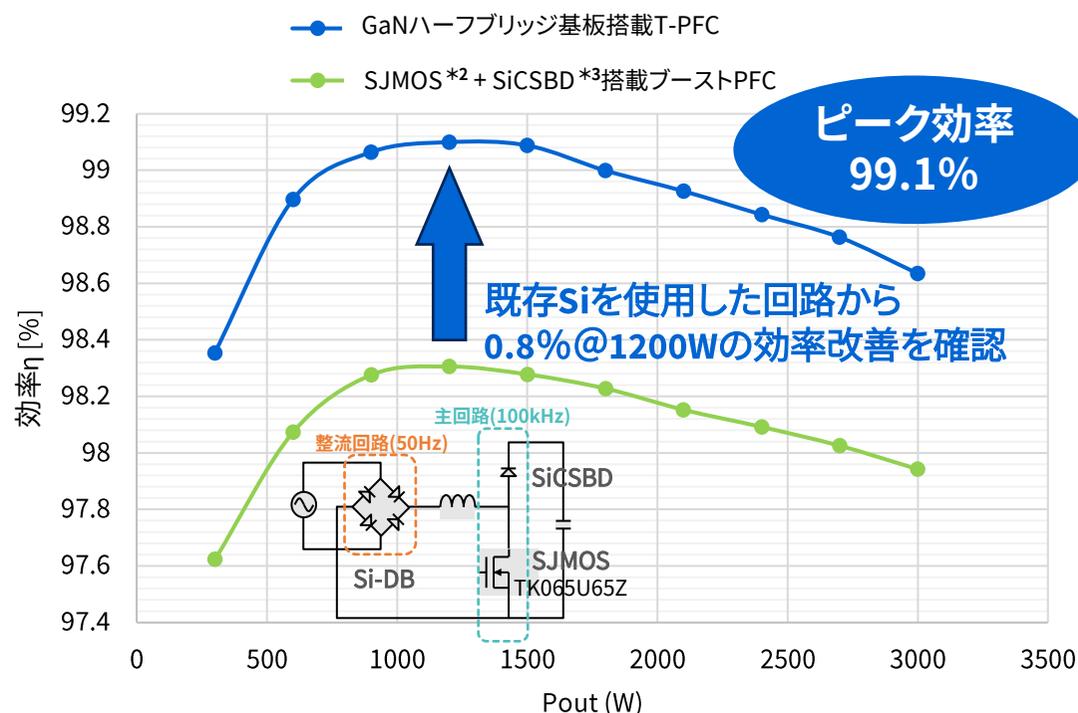
#### ■トータムポールPFC等価回路図



#### ■トータムポールPFC基板写真



#### ■効率カーブ \* テスト条件: Vin=230V<sub>AC</sub>, Vout=400V<sub>DC</sub>, fsw=100kHz



当社 GaN( $R_{DS(ON)}$ : 50m $\Omega$  (typ.))テストサンプルを実装されたT-PFC と、同様の $R_{DS(ON)}$  SJMOS を実装されたBoost PFCの比較

- \*1 PFC : Power Factor Correction
- \*2 SJMOS : Super Junction MOS
- \*3 SiCSBD : Silicon Carbide Schottky Barrier Diode

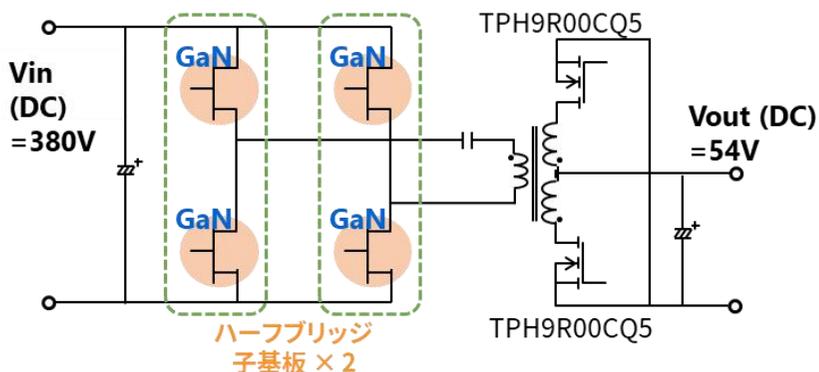
東芝デバイス&ストレージ株式会社

# GaNパワー搭載2.0kWフルブリッジLLC評価ボード

2.0kW Full-bridge LLC evaluation board with Toshiba GaN power device

## GaNパワーサンプル搭載2.0kWフルブリッジLLC評価ボードはピーク効率98.4%を達成

### ■フルブリッジLLC評価ボード回路図

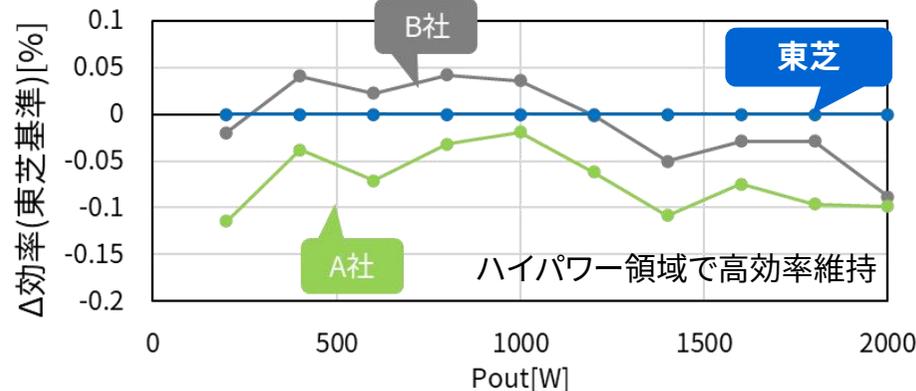
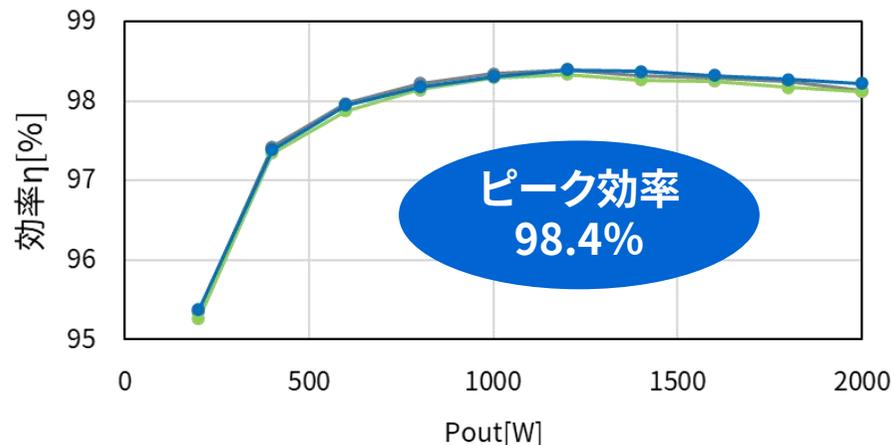


### ■フルブリッジLLC基板写真

Vin (DC)=380V



### ■効率カーブ \* テスト条件: Vin=380V<sub>DC</sub>, Vout=54V<sub>DC</sub>



東芝デバイス&ストレージ株式会社